

## § 57. Структура промежуточного состояния

Форма и размеры  $n$ - и  $s$ -слоев в промежуточном состоянии определяются условиями термодинамического равновесия тела в целом, аналогично тому, как определяется форма доменов в ферромагнетике (§ 44). Как и там, устанавливающаяся толщина слоев является результатом двух противоположных тенденций. Поверхностное натяжение на границах  $n$ - и  $s$ -фаз стремится уменьшить число слоев, т. е. увеличить их толщину. В обратном направлении действует энергия выхода слоев к свободной поверхности тела. Толщина слоев возрастает при увеличении размеров тела, в результате чего (по тем же причинам, что и для ферромагнитных доменов) в конце концов должно наступить их разветвление при подходе к поверхности тела<sup>1)</sup>.

Задача об определении формы и размеров неразветвленных слоев в промежуточном состоянии в плоскопараллельной пластинке может быть решена точно; сделаем это, предполагая внешнее поле  $\mathfrak{H}$  перпендикулярным пластинке (Л. Д. Ландау, 1937).

Слои расположены вдоль поля, и их плоскопараллельность нарушается лишь вблизи поверхности пластинки.

Силовые линии магнитного поля (пунктирные линии на рис. 35) проходят только через  $n$ -слои, причем границы  $s$ -слоев тоже являются силовыми линиями (в силу условия  $B_n = 0$  на них). Учитывая также, что на границе  $n$ - и  $s$ -фаз должно быть  $H = H_c$ , пишем следующие условия на границах  $s$ -слоя:

$$\left. \begin{array}{l} \text{на отрезке } BC: H_x = 0, \\ \text{на } BA \text{ и } CD: H_x^2 + H_y^2 = H_c^2 \end{array} \right\} \quad (57,1)$$

(оси координат выбраны указанным на рис. 35 образом). Вдали от пластинки поле  $\mathbf{H}$  должно совпадать с внешним полем, т. е.

$$\text{при } x \rightarrow -\infty \quad H_x = \mathfrak{H}, \quad H_y = 0. \quad (57,2)$$

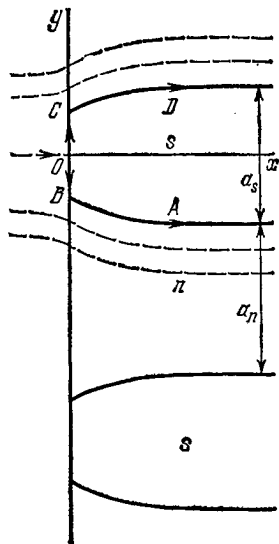


Рис. 35.

<sup>1)</sup> В определенных условиях (внешние поля, близкие к нулю или к  $H_c$ ) термодинамически более выгодной может оказаться не слоистая, а нитевидная структура. См. Andrew E. R.—Proc. Roy. Soc., 1948, v. 194A, p. 98.

Введем скалярный и векторный потенциалы поля согласно формулам

$$H_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{\partial A}{\partial y}, \quad H_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y} = -\frac{\partial A}{\partial x}$$

и комплексный потенциал  $w = \varphi - iA$  (ср. § 3).

Вдоль каждой силовой линии  $A = \text{const}$ . Положим  $A = 0$  на силовой линии, подходящей к точке  $O$  и затем разветвляющейся на линии  $OCD$  и  $OBA$ , образуя границу одного из  $s$ -слоев. Разность значений  $A$  на границах двух последовательных  $s$ -слоев равна потоку магнитного поля через отрезок  $a = a_s + a_n$ , т. е. равна  $\xi a$ . Поэтому значения  $A$  на границах всех  $s$ -слоев будут целыми кратными  $\xi a$ . Вводя также «комплексную напряженность»

$$\eta = H_x - iH_y = -\frac{dw}{dz}, \quad z = x + iy,$$

напишем условия (57,1) в виде:

$$\begin{aligned} \text{на } BC: \operatorname{Re} \eta &= 0, \\ \text{на } BA \text{ и } CD: |\eta| &= H_c. \end{aligned} \quad (57,3)$$

Введем новую величину

$$\zeta = \exp(-2\pi w / \xi a) - 1 \quad (57,4)$$

и будем рассматривать  $\eta$  как функцию от  $\zeta$ . На всех граничных силовых линиях (вместе с их продолжениями вне пластинки) величина  $\zeta$  вещественна:

$$\zeta = \exp(-2\pi\varphi / \xi a) - 1.$$

Поскольку  $\varphi$  определено с точностью до постоянной, то можно произвольно выбрать значение  $\varphi$  в одной точке. Пусть  $\varphi = 0$  в точке  $O$ . Тогда в этой точке и  $\zeta = 0$ . На рассматриваемой граничной силовой линии вдали от пластинки  $\zeta = -1$  (так как при  $x \rightarrow -\infty$  имеем  $\varphi \rightarrow -\xi x \rightarrow +\infty$ ). Значение  $\zeta$  в точке  $B$  (или  $C$ ), где силовая линия входит внутрь пластинки, обозначим как  $\zeta_0$ . На ветвях  $CD$  и  $BA$   $\zeta$  меняется от  $\zeta_0$  до  $\infty$ . Тогда условия (57,1) и (57,3) можно написать в виде:

$$\text{при } \zeta = -1 \quad \eta = \xi, \quad (57,5)$$

$$\begin{aligned} \text{при } 0 < \zeta < \zeta_0 \quad \operatorname{Re} \eta &= 0, \\ \text{при } \zeta_0 < \zeta \quad |\eta| &= H_c. \end{aligned} \quad (57,6)$$

Кроме того, функция  $\eta(\zeta)$  должна быть везде конечной.

Условиям (57,6) удовлетворяет функция

$$\eta = H_c \left[ \sqrt{1 - \frac{\zeta_0}{\zeta}} - \sqrt{-\frac{\zeta_0}{\zeta}} \right]. \quad (57,7)$$

При вещественных отрицательных значениях  $\xi$  оба корня вещественны и берутся с написанными здесь знаками. При  $0 < \xi < \xi_0$  оба корня мнимы, причем берутся корни

$$\eta = \mp H_c i \left[ \sqrt{\frac{\xi_0}{\xi}} - \sqrt{\frac{\xi_0}{\xi} - 1} \right]$$

со знаками  $-$  или  $+$  соответственно на отрезках  $OC$  и  $OB$ . При  $\xi > \xi_0$  надо писать

$$\eta = H_c \left[ \sqrt{1 - \frac{\xi_0}{\xi}} \mp i \sqrt{\frac{\xi_0}{\xi}} \right]$$

со знаками  $-$  и  $+$  соответственно на  $CD$  и  $BA$ . Значение  $\xi_0$  определяется из условия (57,5) и равно

$$\xi_0 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{h} - h \right)^2, \quad (57,8)$$

где введено обозначение  $h = \mathfrak{H}/H_c$ .

Форма слоя, т. е. уравнение граничной силовой линии, получается интегрированием соотношения  $dz = -dw/\eta$  по вещественным  $\xi$ :

$$z = - \int \frac{dw}{\eta} = \frac{ah}{2\pi} \int \frac{d\xi}{\eta(\xi+1)}.$$

Подставив сюда  $\eta(\xi)$ , отделив вещественную и мнимую части и выбрав соответствующим образом постоянные интегрирования, получим следующее параметрическое уравнение линии  $CD$ :

$$\begin{aligned} x &= \frac{ha}{2\pi} \int_{\xi_0}^{\xi} \sqrt{1 - \frac{\xi_0}{\xi}} \frac{d\xi}{\xi+1} = \\ &= \frac{ha}{\pi} \left[ \text{Arch} \sqrt{\frac{\xi}{\xi_0}} - \sqrt{\xi_0+1} \text{Arch} \sqrt{\frac{\xi(\xi_0+1)}{\xi_0(\xi+1)}} \right], \quad (57,9) \end{aligned}$$

$$y = Y - \frac{ha}{2\pi} \int_{\xi}^{\infty} \sqrt{\frac{\xi_0}{\xi}} \frac{d\xi}{\xi+1} = Y - \frac{ha}{\pi} \sqrt{\xi_0} \left( \frac{\pi}{2} - \text{arctg} \sqrt{\xi} \right)$$

( $Y = a_s/2$  — значение координаты  $y$  при  $x \rightarrow \infty$ ; см. рис. 35).

Период слоистой структуры  $a$  связан с толщинами  $a_s$  и  $a_n$   $s$ - и  $n$ -слоев равенствами  $a = a_s + a_n$ ,  $a\mathfrak{H} = a_n H_c$ . Второе из них является следствием непрерывности магнитного потока, проходящего целиком в  $n$ -слоях. Отсюда

$$a_s = a(1-h), \quad a_n = ha.$$

Период  $a$  определяется условием минимальности полного термодинамического потенциала пластинки. Наличие поверхностного натяжения на границе  $n$ - и  $s$ -фаз приводит к члену

$$\mathfrak{F}_1 = \frac{2l}{a} \frac{H_c^2}{8\pi} \Delta \quad (57,10)$$

в термодинамическом потенциале, отнесенном к  $1 \text{ см}^2$  поверхности пластинки. Здесь  $l$  — толщина пластинки, а коэффициент поверхностного натяжения обозначен как  $H_c^2 \Delta / 8\pi$  ( $\Delta$  имеет размерность длины). При вычислении этой части энергии закруглением слоев вблизи поверхности пластинки можно, конечно, пренебречь.

Энергию выхода слоев к поверхности пластинки можно представить в виде суммы двух частей. Во-первых, само по себе увеличение объема  $n$ -слоев по сравнению с объемом, который они имели бы при сохранении плоскопараллельности на всем протяжении, приводит к дополнительной энергии

$$\mathcal{F}_2 = \frac{4}{a} \int_0^{\infty} (Y - y) dx \frac{H_c^2}{8\pi} \quad (57,11)$$

(множитель 4 учитывает наличие четырех углов — таких, как  $B$  и  $C$  на рис. 35 — с обеих сторон каждого из  $1/a$   $s$ -слоев).

Во-вторых, выход слоев к поверхности пластинки меняет энергию системы во внешнем поле, т. е. энергию —  $\mathcal{M}\xi/2$ . Магнитный момент пластинки обусловлен токами на поверхностях  $s$ -слоев. При скачке тангенциальной компоненты индукции от  $H$  до 0 поверхностная плотность токов  $g = \pm cH/4\pi$ . Поэтому на единицу длины оси  $z$  на каждую граничную поверхность  $s$ -слоя приходится магнитный момент

$$- \int_{OC'D} \frac{H}{4\pi} y ds \quad (ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}).$$

Если бы слой не выходил к поверхности, отрезок  $OC$  отсутствовал бы, а на  $CD$  было бы везде  $y = Y$ . Поэтому избыток магнитного момента для каждого из четырех углов равен

$$- \int_{OC'D} \frac{H}{4\pi} y ds + \int_0^{\infty} \frac{H_c}{4\pi} Y dx.$$

Соответственно, избыточная энергия

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_3 &= - \frac{\xi}{2} \frac{4}{a} \left[ \int_0^{\infty} \frac{H_c}{4\pi} Y dx - \int_{OC'D} \frac{H}{4\pi} y ds \right] = \\ &= \frac{\xi}{2a\pi} \left[ H_c \int_{CD} (-Y dx + y ds) + \int_{OC} Hy dy \right]. \quad (57,12) \end{aligned}$$

Координаты  $x$  и  $y$ , выраженные через  $\xi$ , пропорциональны  $a$ . Поэтому все интегралы в  $\mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2$  пропорциональны  $a^2$ , так что эта часть термодинамического потенциала пропорциональна  $a$ .

Сумма же  $\mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 + \mathcal{F}_3$  имеет, следовательно, вид

$$\mathcal{F} = \frac{H_c^2}{4\pi} \left[ \frac{l\Delta}{a} + af(h) \right]. \quad (57,13)$$

Условие ее минимальности дает

$$a = \sqrt{\frac{l\Delta}{f(h)}}. \quad (57,14)$$

Интегралы в (57,11—12) могут быть вычислены до конца<sup>1)</sup>, и для функции  $f(h)$  получается следующее выражение:

$$f(h) = \frac{1}{4\pi} \{ (1+h)^4 \ln(1+h) + (1-h)^4 \ln(1-h) - \\ - (1+h^2)^2 \ln(1+h^2) - 4h^2 \ln 8h \}. \quad (57,15)$$

Предельные выражения этой функции:

$$f(h) = \frac{h^2}{\pi} \ln \frac{0,56}{h} \quad \text{при} \quad h \ll 1; \\ f(h) = \frac{\ln 2}{\pi} (1-h)^2 \quad \text{при} \quad 1-h \ll 1. \quad (57,16)$$

На рис. 36 изображен график функции  $f(h)$ .

Отметим, что в  $n$ -слоях вблизи поверхности пластинки магнитное поле может быть существенно меньшим, чем  $H_c$ , т. е. здесь имеет место ситуация, соответствующая изображенной на рис. 33,  $a^2$ ). Ее термодинамическая невыгодность компенсируется в данном случае энергией поверхностного натяжения, препятствующей дальнейшему уменьшению толщины слоев.

Как уже указывалось, при увеличении толщины пластинки должно наступить разветвление слоев. Это приводит, в свою очередь, к изменению зависимости периода структуры  $a$  от  $l$ ; в предельном случае многократного разветвления  $a \propto l^{2/3}$ . Фактические численные соотношения показывают, однако, что разветвление должно начаться сравнительно поздно<sup>3)</sup>.

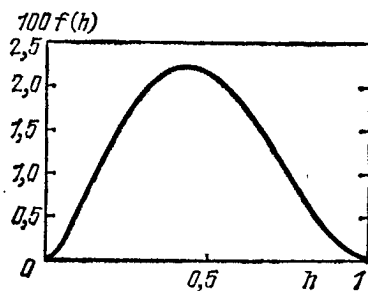


Рис. 36.

<sup>1)</sup> См. Fortini A., Paumier E.—Phys. Rev. B, 1972, v. 5, p. 1850.

<sup>2)</sup> Так, при  $h=1/2$  поле на поверхности в средней точке  $n$ -слоя составляет всего  $0,73 H_c$ , а при  $h \rightarrow 0$  стремится к  $0,65 H_c$ .

<sup>3)</sup> Расчет модели с многократным разветвлением слоев — см. Ландау Л. Д.—ЖЭТФ, 1943, т. 13, с. 377 (Собрание трудов, статья 47, «Наука», 1969).